単電子反応拡散回路における平行波の伝搬方向制御に関する検討

Study on controlling direction of plane wave propagation in single-electron reaction-diffusion circuit O田村啓一朗、大矢剛嗣(横国大理工)

^OKeiichiro Tamura, Takahide Oya (Yokohama National Univ.)

Email: tamura-keiichiro-pd@ynu.jp

【研究背景・目的】

単電子回路とは、電子を一個単位で制御可能 な電子デバイスであり、非線形性や高集積性、 確率動作性に優れる。ナノテクノロジーの発展 に伴い単電子回路は注目されてきていたが、最 適な情報処理手法は未確立である。本研究では、 Belousov-Zhabotinsky(BZ)反応という化学反応 に注目し、その特徴を単電子回路の挙動に結び 付ける。BZ 反応は、特定の溶液を混合したと きに溶液の色が時間的に振動する反応のこと であり、シャーレに溶液を入れると反応が波の ように広がることが知られる。また、そのよう な応答をモデル化したものを反応拡散系と呼 ぶ。BZ 反応の特徴の一つに、光を当てると反 応が抑制される。つまり光の照射の制御により 波が特定の方向にのみ進むようになる(平行波 になる)。この特徴は、論理ゲートの表現に利 用できることが報告されている^[1,2]。また、単 電子回路では電子トンネルによる電圧変化の 伝播を波の広がりと見立てられる[3]。本研究で は、BZ 反応に基づく単電子反応拡散回路にお ける平行波の表現と安定化を目的とする。

【研究内容】

単電子振動子を二次元平面上にコンデンサを介して繋げた層 (Fig. 1) を二層用意し、それぞれ波の伝搬と抑制の機能を持たせることで平行波を表現した。波の伝播は文献[3]と同様に、電子トンネルが連鎖的に広がるようにバイアス電圧を設定することで表現した。

前回の報告では、多重トンネル接合を用いる ことによる単電子反応拡散回路における平行 波の進行の成功率の向上について説明した^[4]。 一方で、論理ゲートの表現には所望の方向に波 を進行させる必要があり、回路の改良が必要で あるということも明らかになった。

今回は、前回報告の回路の発展形として斜め 方向の平行波の表現について報告する。斜め方 向の波の表現はトリガを与える振動子同士に 角度をつけることで行った。また、論理ゲート の表現を目指し、平行波伝播の成功率の向上の 検証についても行った。詳細は講演にて述べる。

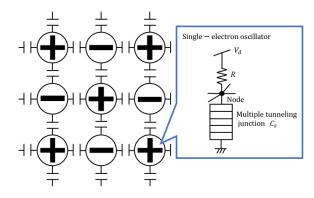


Fig. 1 Two-dimensional array of single-electron oscillators using multiple tunneling junctions.

(+/- indicates polarity of V_d .)

【参考文献】

- [1] A. Adamatzky, PLoS ONE 11, e0168267, (2016).
- [2] M.-A Tsompanas, et al., Biosystems **206**, 10447, (2016).
- [3] T. Oya, et al., Int'l J. Unconv. Comp. 1, 177, (2005).
- [4]田村啓一朗, 他, 第 83 回応物学会秋季学術 講演会, 21p-A102-8, (2022).

【謝辞】

本研究の一部は JSPS 科研費・基盤研究(A) (JP18H03766), (B)(JP19H02545)、および(公財)栢森情報科学振興財団の助成を受け実施された。